

# GaAIAs Light Emitting Diode (660 nm)

## GaAIAs-Lumineszenzdiode (660 nm)

### Version 1.1

---

#### SFH 464 E7800



#### Features:

- Radiation without IR in the visible red range
- Cathode is electrically connected to the case
- High reliability
- Short switching times
- Same package as BP 103, LD 242
- DIN humidity category in acc. with DIN 40 040 GQG

#### Applications

- Photointerrupters
- Fiber optic transmission
- Sensor technology
- Light curtains

#### Notes

Depending on the mode of operation, these devices emit highly concentrated non visible infrared light which can be hazardous to the human eye. Products which incorporate these devices have to follow the safety precautions given in IEC 60825-1 and IEC 62471.

#### Besondere Merkmale:

- Strahlung im sichtbaren Rotbereich ohne IR-Anteil
- Kathode galvanisch mit dem Gehäuseboden verbunden
- Hohe Zuverlässigkeit
- Kurze Schaltzeiten
- Gehäusegleich mit BP 103, LD 242
- Anwendungsklassen nach DIN 40 040 GQG

#### Anwendungen

- Lichtschranken
- LWL
- Sensorik
- Lichtgitter

#### Hinweise

Je nach Betriebsart emittieren diese Bauteile hochkonzentrierte, nicht sichtbare Infrarot-Strahlung, die gefährlich für das menschliche Auge sein kann. Produkte, die diese Bauteile enthalten, müssen gemäß den Sicherheitsrichtlinien der IEC-Normen 60825-1 und 62471 behandelt werden.

## Ordering Information

## Bestellinformation

<b>Type:</b>	<b>Radiant Intensity</b> <sup>1) page 9</sup>	<b>Ordering Code</b>
<b>Typ:</b>	<b>Strahlstärke</b> <sup>1) Seite 9</sup> $I_F = 50 \text{ mA}$ , $t_p = 20 \text{ ms}$ $I_e \text{ [mW/sr]}$	<b>Bestellnummer</b>
SFH 464 E7800	1.5 ( $\geq 1$ )	Q62702P1745

Maximum Ratings ( $T_A = 25 \text{ }^\circ\text{C}$ )

## Grenzwerte

Parameter Bezeichnung	Symbol Symbol	Values Werte	Unit Einheit
Operation and storage temperature range Betriebs- und Lagertemperatur	$T_{op}$ ; $T_{stg}$	-40 ... 80	$^\circ\text{C}$
Reverse voltage Sperrspannung	$V_R$	3	V
Forward current Durchlassstrom	$I_F$	50	mA
Surge current Stoßstrom ( $t_p \leq 10 \text{ } \mu\text{s}$ , $D = 0$ )	$I_{FSM}$	1	A
Total power dissipation Verlustleistung	$P_{tot}$	140	mW
Thermal resistance junction - ambient Wärmewiderstand Sperrschicht - Umgebung	$R_{thJA}$	450	K / W
Thermal resistance junction - case Wärmewiderstand Sperrschicht - Gehäuse	$R_{thJC}$	160	K / W
ESD withstand voltage ESD Festigkeit (acc. to ANSI/ ESDA/ JEDEC JS-001 - HBM)	$V_{ESD}$	2	kV

Characteristics ( $T_A = 25\text{ °C}$ )

## Kennwerte

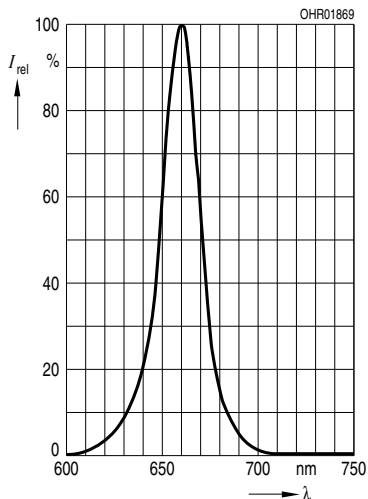
Parameter Bezeichnung	Symbol Symbol	Values Werte	Unit Einheit
Emission wavelength Zentrale Emissionswellenlänge ( $I_F = 50\text{ mA}$ , $t_p = 20\text{ ms}$ )	$\lambda_{\text{peak}}$	660	nm
Spectral bandwidth at 50% of $I_{\text{max}}$ Spektrale Bandbreite bei 50% von $I_{\text{max}}$ ( $I_F = 50\text{ mA}$ , $t_p = 20\text{ ms}$ )	$\Delta\lambda$	25	nm
Half angle <sup>1) page 9</sup> Halbwinkel <sup>1) Seite 9</sup>	$\varphi$	$\pm 23$	°
Active chip area Aktive Chipfläche	A	0.1	mm <sup>2</sup>
Dimensions of active chip area Abmessungen der aktiven Chipfläche	L x W	0.325 x 0.325	mm x mm
Distance chip front to case surface Abstand Chipoberfläche bis Gehäusevorderseite	H	0.3 ... 0.7	mm
Rise and fall time of $I_e$ ( 10% and 90% of $I_{e\text{max}}$ ) Schaltzeit von $I_e$ ( 10% und 90% von $I_{e\text{max}}$ ) ( $I_F = 50\text{ mA}$ , $R_L = 50\ \Omega$ )	$t_r, t_f$	100	ns
Capacitance Kapazität ( $V_R = 0\text{ V}$ , $f = 1\text{ MHz}$ )	$C_0$	30	pF
Forward voltage Durchlassspannung ( $I_F = 50\text{ mA}$ , $t_p = 20\text{ ms}$ )	$V_F$	2.1 ( $\leq 2.8$ )	V
Reverse current Sperrstrom ( $V_R = 3\text{ V}$ )	$I_R$	0.01 ( $\leq 10$ )	$\mu\text{A}$
Total radiant flux Gesamtstrahlungsfluss ( $I_F = 50\text{ mA}$ , $t_p = 20\text{ ms}$ )	$\Phi_e$	11	mW
Temperature coefficient of $I_e$ or $\Phi_e$ Temperaturkoeffizient von $I_e$ bzw. $\Phi_e$ ( $I_F = 50\text{ mA}$ , $t_p = 20\text{ ms}$ )	$TC_I$	-0.4	% / K

Parameter Bezeichnung	Symbol Symbol	Values Werte	Unit Einheit
Temperature coefficient of $V_F$ Temperaturkoeffizient von $V_F$ ( $I_F = 50$ mA, $t_p = 20$ ms)	$TC_V$	-3	mV / K
Temperature coefficient of wavelength Temperaturkoeffizient der Wellenlänge ( $I_F = 50$ mA, $t_p = 20$ ms)	$TC_\lambda$	0.16	nm / K
Radiant intensity <sup>1) page 9</sup> Strahlstärke <sup>1) Seite 9</sup> ( $I_F = 50$ mA, $t_p = 20$ ms)	$I_{e, \min}$	1	mW / sr

### Relative Spectral Emission

#### Relative spektrale Emission

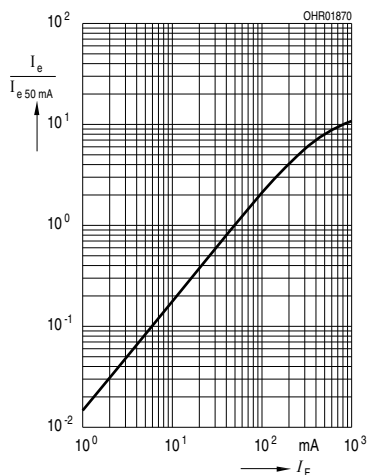
$$I_{\text{rel}} = f(\lambda), T_A = 25^\circ\text{C}$$



### Radiant Intensity

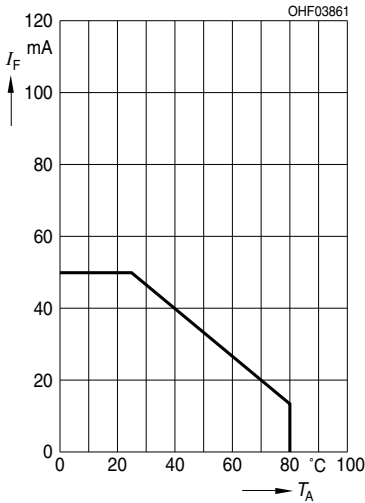
#### Strahlstärke

$$I_e / I_e(50\text{mA}) = f(I_F), \text{ single pulse, } t_p = 20 \mu\text{s}, T_A = 25^\circ\text{C}$$



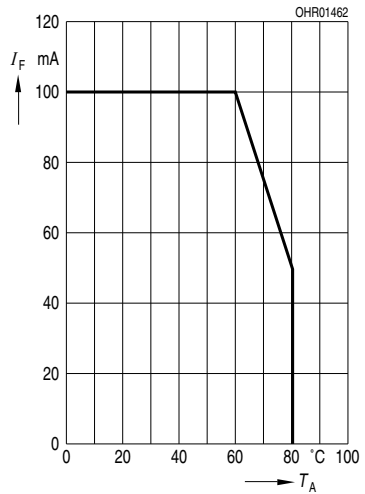
**Max. Permissible Forward Current**  
**Max. zulässiger Durchlassstrom**

$I_{F, \max} = f(T_A), R_{thJA} = 450 \text{ K/W}$



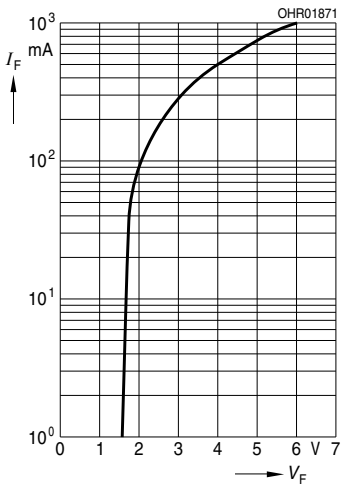
**Max. Permissible Forward Current**  
**Max. zulässiger Durchlassstrom**

$I_{F, \max} = f(T_C), R_{thJC} = 160 \text{ K/W}$



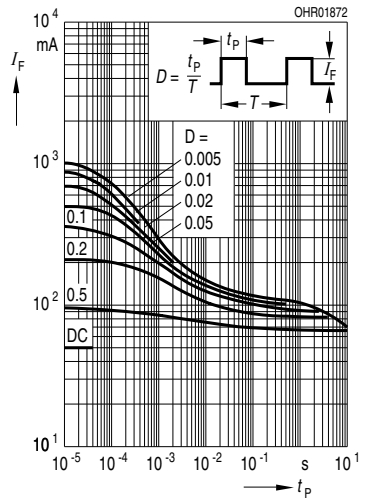
**Forward Current**  
**Durchlassstrom**

$I_F = f(V_F)$ , single pulse,  $t_p = 100 \mu\text{s}$ ,  $T_A = 25^\circ\text{C}$



**Permissible Pulse Handling Capability**  
**Zulässige Pulsbelastbarkeit**

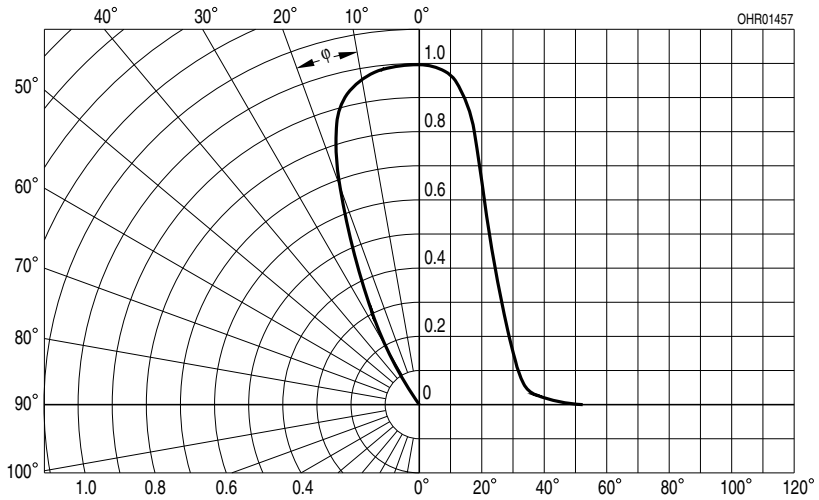
$I_F = f(t_p)$ ,  $T_A = 25^\circ\text{C}$ , duty cycle  $D =$  parameter



## Radiation Characteristics

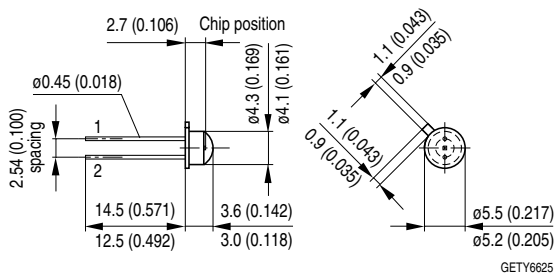
## Abstrahlcharakteristik

$$I_{\text{rel}} = f(\varphi)$$



## Package Outline

## Maßzeichnung



Dimensions in mm (inch). / Maße in mm (inch).

### Pinning Anschlussbelegung

Pin	Description
Anschluss	Beschreibung
1	Anode / Anode
2	Cathode / Kathode

### Package

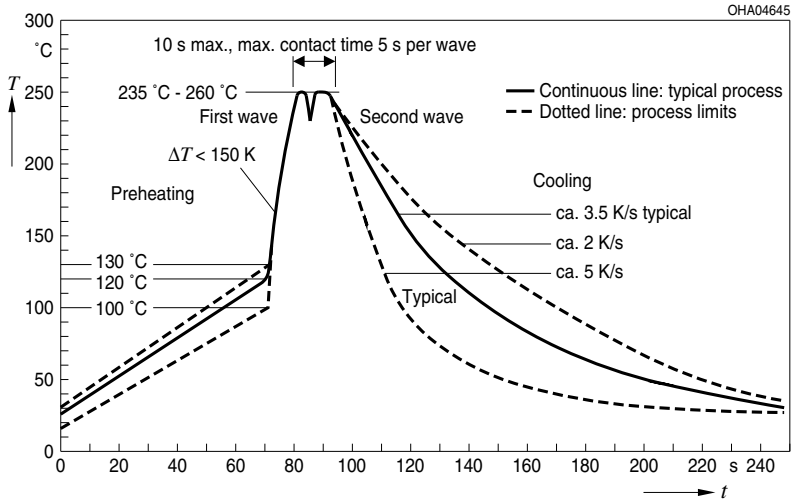
Metal Can (TO-18), solder tabs lead spacing 2.54 mm ( $1/10''$ ), anode marking: projection at package bottom, Epoxy, clear resin

### Gehäuse

Metall Gehäuse (TO-18), Anschlüsse im 2.54 mm-Raster ( $1/10''$ ), Anodenkennzeichnung: Nase am Gehäuseboden, Harz, klarer Verguss

### TTW Soldering Wellenlöten (TTW)

IEC-61760-1 TTW / IEC-61760-1 TTW



## Disclaimer

### Attention please!

The information describes the type of component and shall not be considered as assured characteristics.

Terms of delivery and rights to change design reserved.

Due to technical requirements components may contain dangerous substances.

For information on the types in question please contact our Sales Organization.

If printed or downloaded, please find the latest version in the Internet.

### Packing

Please use the recycling operators known to you. We can also help you – get in touch with your nearest sales office.

By agreement we will take packing material back, if it is sorted. You must bear the costs of transport. For packing material that is returned to us unsorted or which we are not obliged to accept, we shall have to invoice you for any costs incurred.

### Components used in life-support devices or systems must be expressly authorized for such purpose!

Critical components\* may only be used in life-support devices\*\* or systems with the express written approval of OSRAM OS.

\*) A critical component is a component used in a life-support device or system whose failure can reasonably be expected to cause the failure of that life-support device or system, or to affect its safety or the effectiveness of that device or system.

\*\*) Life support devices or systems are intended (a) to be implanted in the human body, or (b) to support and/or maintain and sustain human life. If they fail, it is reasonable to assume that the health and the life of the user may be endangered.

## Disclaimer

### Bitte beachten!

Lieferbedingungen und Änderungen im Design vorbehalten. Aufgrund technischer Anforderungen können die Bauteile Gefahrstoffe enthalten. Für weitere Informationen zu gewünschten Bauteilen, wenden Sie sich bitte an unseren Vertrieb. Falls Sie dieses Datenblatt ausgedruckt oder heruntergeladen haben, finden Sie die aktuellste Version im Internet.

### Verpackung

Benutzen Sie bitte die Ihnen bekannten Recyclingwege. Wenn diese nicht bekannt sein sollten, wenden Sie sich bitte an das nächstgelegene Vertriebsbüro. Wir nehmen das Verpackungsmaterial zurück, falls dies vereinbart wurde und das Material sortiert ist. Sie tragen die Transportkosten. Für Verpackungsmaterial, das unsortiert an uns zurückgeschickt wird oder das wir nicht annehmen müssen, stellen wir Ihnen die anfallenden Kosten in Rechnung.

### Bauteile, die in lebenserhaltenden Apparaten und Systemen eingesetzt werden, müssen für diese Zwecke ausdrücklich zugelassen sein!

Kritische Bauteile\* dürfen in lebenserhaltenden Apparaten und Systemen\*\* nur dann eingesetzt werden, wenn ein schriftliches Einverständnis von OSRAM OS vorliegt.

\*) Ein kritisches Bauteil ist ein Bauteil, das in lebenserhaltenden Apparaten oder Systemen eingesetzt wird und dessen Defekt voraussichtlich zu einer Fehlfunktion dieses lebenserhaltenden Apparates oder Systems führen wird oder die Sicherheit oder Effektivität dieses Apparates oder Systems beeinträchtigt.

\*\*) Lebenserhaltende Apparate oder Systeme sind für (a) die Implantierung in den menschlichen Körper oder (b) für die Lebenserhaltung bestimmt. Falls Sie versagen, kann davon ausgegangen werden, dass die Gesundheit und das Leben des Patienten in Gefahr ist.



## Glossary

- 1) **Radiant intensity / Half angle:** An aperture is used in front of the component for measurement of the radiant intensity and the half angle (diameter of the aperture: 1.1 mm; distance of aperture to case back side: 4.0 mm). This ensures that solely the radiation in axial direction emitting directly from the chip surface will be evaluated during measurement of the radiant intensity. Radiation reflected by the bottom plate (stray radiation) will not be evaluated. These reflections impair the projection of the chip surface by additional optics (e.g. long-range light reflection switches). In respect of the application of the component, these reflections are generally suppressed by apertures as well. This measuring procedure corresponding with the application provides more useful values. This aperture measurement is denoted by "E 7800" added to the type designation.

## Glossar

- 1) **Strahlstärke / Halbwinkel:** Die Messung der Strahlstärke und des Halbwinkels erfolgt mit einer Lochblende vor dem Bauteil (Durchmesser der Lochblende: 1,1 mm; Abstand Lochblende zu Gehäuserückseite: 4,0 mm). Dadurch wird sichergestellt, dass bei der Strahlstärkemessung nur diejenige Strahlung in Achsrichtung bewertet wird, die direkt von der Chipoberfläche austritt. Von der Bodenplatte reflektierte Strahlung (vagabundierende Strahlung) wird dagegen nicht bewertet. Diese Reflexionen sind besonders bei Abbildungen der Chipoberfläche über Zusatzoptiken störend (z. B. Lichtschranken großer Reichweite). In der Anwendung werden im allgemeinen diese Reflexionen ebenfalls durch Blenden unterdrückt. Durch dieses der Anwendung entsprechende Messverfahren ergibt sich für die Anwender eine besser verwertbare Größe. Diese Lochblendenmessung ist gekennzeichnet durch den Eintrag "E 7800", der an die Typenbezeichnung angehängt ist.

Published by OSRAM Opto Semiconductors GmbH  
Leibnizstraße 4, D-93055 Regensburg  
[www.osram-os.com](http://www.osram-os.com) © All Rights Reserved.

EU RoHS and China RoHS compliant product



此产品符合欧盟 RoHS 指令的要求；  
按照中国的相关法规和标准，不含有毒有害物质或元素。